

2SD317, 2SD317A, 2SD318, 2SD318A

(2SD317, 2SD317A, 2SD318, 2SD318A : 保守品種/MAINTENANCE)

シリコン NPN 拡散接合メサ型/Si NPN Diffused Junction Mesa

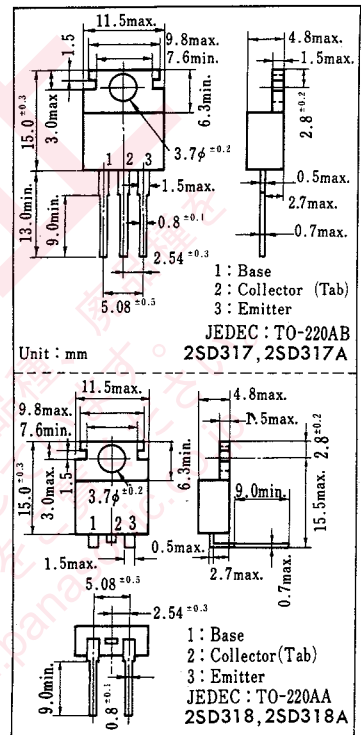
中出力電力増幅用/Medium Power Amplifier

特徴/Features

- コレクタ損失 P_C が大きい。/Large collector dissipation
- 安全動作領域 (ASO) が広い。/Wide area of safe operation
- 2SD318, 2SD318A はリードを整形し TO-66 タイプへの置換が可能です。/With lead forming, fits to TO-66 socket.

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
2SD317/318 2SD317A/ 318A		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
2SD317/318 2SD317A/ 318A		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	8	V
コレクタ電流	I_C	3	A
ベース電流	I_B	1	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	25	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}$	$I_C=0.2A, L=25mH$	60			V
2SD317/318 2SD317A/318A			80			
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20V, I_B=0$			30	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=8V, I_C=0$			1.0	mA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=3V, I_C=0.1A$	40			
	h_{FE2}^*	$V_{CE}=3V, I_C=1A$	30	60	160	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=3V, I_C=1A$			1.4	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=0.4A$			1.0	V
シャ断周波数	$f_{\alpha e}$	$V_{CE}=10V, I_C=0.2A$		25		kHz

* h_{FE2} ランク分類/ h_{FE2} Classifications

h_{FE2}	30~60	50~100	80~160
分類	Q	P	O